

Literatura

- [1] Frank, H. - Šnejdar, V.: Principy a vlastnosti polovodičových součástek. Praha, SNTL 1976
- [2] Graff de, H.C. - Klaasen, F.M.: Compact Transistor Modeling for Circuit Design, Wien - New York : Springer Verlag 1990
- [3] Tomeš, M. - Brzobohatý, J.: Modelování a navrhování mikroelektronických obvodů. Praha, SNTL 1983. Skriptum VUT Brno
- [4] Musil, V. - Tomeš, M.: Modelování a navrhování mikroelektronických prvků a obvodů. Praha, SNTL 1984, Skriptum VUT Brno
- [5] Musil, V. - Brzobohatý, J. - Tomeš, M.: Navrhování mikroelektronických obvodů. Brno, Ediční středisko VUT Brno 1985
- [6] Bubennikov, A.N.: Modelirovanie integralnych mikrotechnologij, priborov i schem. Moskva, Vysšaja škola 1989
- [7] Antognetti, P. - Massobrio, G.: Semiconductor Device Modelling with SPICE. New York, McGraw-Hill Book Company 1988
- [8] Warner, R.M.- Grung, B.L.: Transistors Fundamentals for the Integrated-Circuit Engineer. New York: John Wiley and Sons 1983
- [9] Kurata, M.: Numerical analysis for semiconductor devices, Toronto, Lexington Books 1982
- [10] Selberherr, S.: Analysis and Simulation of Semiconductor Devices. Wien, Springer-Verlag 1984
- [11] Berka, Z.: Analýza vlastností polovodičových struktur samočinným počítačem. Slaboproudý obzor 36 (1975), č.6, str. 259 až 264
- [12] Křivohlávek, J.: Matematické modely polovodičových struktur. Slaboproudý obzor 44 (1983), č.3, str. 123 až 127
- [13] Křivohlávek, J.: Dvoudimenzionální model tranzistoru MESFET na bázi GaAs. Slaboproudý obzor 45 (1984), č.7, str. 306 až 313
- [14] Křivohlávek, J.: Jednorozměrný matematický model bipolárního tranzistoru. Slaboproudý obzor 47 (1986), č.11, 12, str. 548 až 554
- [15] Křivohlávek, J.: Jednorozměrný stacionární model diody a tranzistoru. Slaboproudý obzor 48 (1987), č.8, str. 374 až 379
- [16] Křivohlávek, J.: Modelování polovodičových součástek. Československý časopis pro fyziku (sekce A) 37 (1987), str. 127 až 139
- [17] Dobeš, J.: Analýza vícerozměrných dynamických modelů polovodičových struktur. Slaboproudý obzor 47 (1986) č.7, str. 318 až 323
- [18] Bednář, J.: Fyzikální veličiny v modelované polovodičové struktuře. Slaboproudý obzor 47 (1986), č.8, str. 371 až 376
- [19] Polskij, B.S.: Číselnoe modelizovanie poluprovodnikovych priborov. Riga, Zinatne 1986
- [20] Meyer, J.: MOS Models and Circuit Simulation. RCA Rev. 32, březen 1971, str. 42 až 63
- [21] Nosov, J.R.- Petrosjanc, K.O.- Šilin, V.A.: Matematičeskoe modeli elementov integralnoj elektroniky. Moskva, Sovetskoje radio 1976

- [22] Trutko, A.F.: Metody rasčeta tranzistorov. Moskva, Energija 1971
- [23] Marciniak, W.: Modele elementov polprzewodnikowych. Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne 1985
- [24] Getreu, J.E.: Modeling the Bipolar Transistor. Amsterdam. Elsevier 1978
- [25] Ebers, J.J.- Moll, J.L.: Large-Signal Behavior of Junction Transistors. Proceeding of the IRE 42 (1954), č.12, str. 1761 až 1772
- [26] Čachmachsazjan, E.A.- Barmakov, J.N.- Goldenberg, A.E.: Mašinnyj analiz integralnych schem. Moskva. Sovetskoe radio 1974
- [27] Žilka, Z.: Modely tranzistoru pro velké signály. Slaboproudý obzor 30 (1969) č.7, str. P 13 - P 16
- [28] Žilka, Z.: Statické parametry diodového modelu tranzistoru. Slaboproudý obzor 31 (1970) č.7, str. 312 - 317
- [29] Žilka, Z.: Identifikace parametrů injekčního modelu tranzistoru. Slaboproudý obzor 35 (1974) č.5, str. 201 - 205
- [30] Žilka, Z.: Ebersův-Mollův model bipolárního tranzistoru a jeho varianty. Slaboproudý obzor 36 (1975), č.7, str. 322 - 327
- [31] Žilka, Z.: Identifikace parametrů stejnosměrného transportního modelu tranzistoru, Tesla Elektronik 1975, č.3, str. 97 - 106
- [32] Žilka, Z.: Teplotně závislý model bipolárního tranzistoru a diody. Slaboproudý obzor 38 (1977), č.6, str. 253 - 258
- [33] Jiřina, M.- Barešová, B.- Šťastná, H.: Teplotní vlastnosti Ebersova-Mollova modelu tranzistoru. Slaboproudý obzor 32 (1971), č.4, str.149 až 156
- [34] Václavík, M.- Strakoš, V.: Rozšíření klasického Grovova modelu tranzistoru. Slaboproudý obzor 48 (1987), č. 11, str. 519 - 522
- [35] Ilin, V.N.: Mašinnoe proektizovanie elektronnych schem. Moskva, Energija 1972
- [36] Horák, Z.- Krupka, F.: Fyzika. Praha, SNTL 1976
- [37] Bronštejn, J.N.- Semendjajev, K.A.: Spravočnik po matematike. Moskva. GITTL 1956
- [38] Stěpanenko, J.P.: Osnovy teorii tranzistorov i tranzistornych schem. Moskva, Energija 1977
- [39] Poon, H.C.- Gummel, H.K.: Modeling of Emitter Capacitance. Proceedings of the IEEE, December 1969, str. 2181 - 2182
- [40] Berman, L.C.: Nelinejnaja poluprovodnikovaja jomkošť. Moskva, Fizmatgiz 1963
- [41] Pasynkov, V.V.- Čirkin, L.K.: Poluprovodnikovyye pribory. Moskva, Vysšaja škola 1987
- [42] Shichman, H.- Hodges, D.A.: Modeling and Simulation of Insulated - Gate Field Effect Transistor Switching Circuits. IEEE Journal of Solid-state Circuits, vol.SC-3, No.3, September 1968, str.285 - 289
- [43] Beneš, O.: Identifikace parametrů modelů tranzistorů MOS. Slaboproudý obzor 41 (1980), č.8, str. 365 až 371
- [44] Herskowitz, G.J.- Schilling, R.B.: Semiconductor device modeling for computer-aided design. New York, McGraw-Hill 1972

- [45] Vaníček, F.: Polovodičové struktury. Praha, Ediční středisko ČVUT 1983, 1986, 1990. Skriptum FEL ČVUT
- [46] Daniel, M.E.: Development of mathematical models of semiconductor devices for computer-aided circuit analysis. Proc. IEEE 55 (1967), č.11, str. 1813 - 1920
- [47] Kubát, M.: Výkonová polovodičová technika. Praha, SNTL 1978
- [48] Webster, W.M.: On the Variation of Junction-Transistor Current-Amplification Factor with Emitter Current. Proceedings of the IRE 1954, June, str. 914 až 920
- [49] Přehnal, V.: Křemíková dioda jako teplotní čidlo. Sborník z konference "Měření teploty v chemii". ČVTS Pardubice 1976
- [50] Vepřek, J.- Strnad, P.: Dlouhodobá stálost křemíkových planárně epitaxních diod TESLA typu KA 136 a KA 213-NH jako snímačů nízkých teplot v rozsahu 4,2 až 273 K. Slaboproudý obzor 44 (1983), č.5, str. 215 až 221
- [51] Spindonov, N.S.: Osnovy teorii tranzistorov. Kijev, Technika 1975
- [52] Warner, R.M.: Integrated Circuits Design Principles and Fabrication. New York. McGraw-Hill Book Company 1965
- [53] Rževkin, K.S.: Fizičeskíe princípy dějstvija poluprovodnikovych priborov. Moskva. Izdatělstvo Moskovskovo universitěta 1986
- [54] Fibich, Z. a kol.: Křemíkové vysokofrekvenční výkonové tranzistory. Praha, SNTL 1984
- [55] Musil, V.- Brzobohatý, J.- Szántó, L.- Tomeš, M.: Navrhování mikroelektronických obvodů I. Brno, Nakladatelství VUT 1991, Skriptum VUT
- [56] Streetman, B.G.: Solid State Electron Devices. London. Prentice Hall 1972
- [57] Till, W.C.- Luxon, J.T.: Integrated Circuits: materials, devices and fabrication. Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1982
- [58] Kirk, C.T.: A Theory of Transistor Cutoff Frequency (f_T) Falloff at High C Current Densities. IRE Transaction od Electron Devices, Vol. ED-9, str. 164 až 174, March 1962
- [59] Musil, V. a kol.: Technologické procesy a jejich modelování II. Brno, Ediční středisko VUT 1990. Skriptum VUT Brno
- [60] Aitchison, R.E.: The Common Emitter d.c. Characteristic of Transistors in the Saturation Region. Proceedings. I.R.E.E Australia, September 1968, str. 334 až 335
- [61] Marciniak, W.: Polovodičové součástky typu MIS. Praha-SNTL 1979
- [62] Czabay, O.: Integrované obvody I. Časť 1. Bratislava 1990, Skriptum SVŠT
- [63] Szantó, L.: Model tranzistoru pro obvodovou analýzu integrovaných obvodů typu MOS. Slaboproudý obzor 36 (1975), č.6, str.265 až 268
- [64] Grove, A.S.: Physics and Technology of Semiconductor Devices. New York. John Wiley and Sons 1967
- [65] Sze, S.M.: Physics of Semiconductor Devices. New York, John Wiley and Sons 1981